

SIMOS Elektronik Vertriebs GmbH * Fraunhoferstr. 9 * 85221 Dachau

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten gerade den ersten Newsletter der Firma SIMOS Elektronik Vertriebs GmbH in Ihren Händen. Die vielen neuen Produkte unserer Hersteller machen es erforderlich, Ihnen eine kompakte Zusammenfassung der neuesten Technologien und Bausteine in regelmäßigen Abständen zukommen zu lassen. Zögern Sie nicht uns anzurufen, wenn Sie mehr Informationen benötigen oder wenn wir Ihnen ein Angebot erstellen dürfen.

Ihr SIMOS Team

nvSRAM—Schnelle nichtflüchtige Speicher mit hoher Datensicherheit

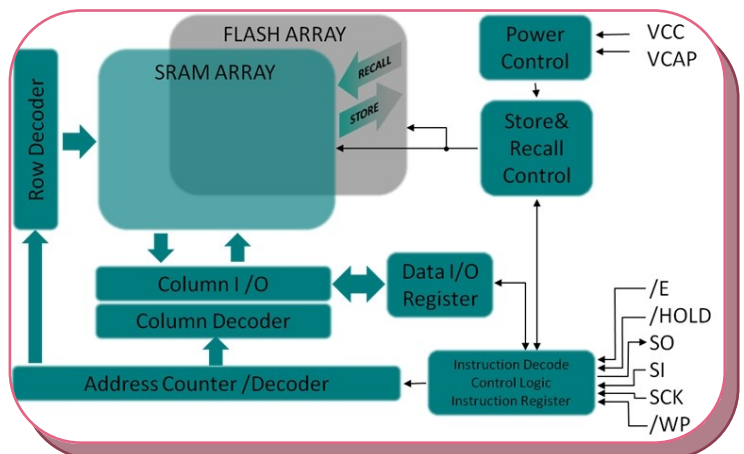
In unseren ersten Newsletter-Ausgabe präsentieren wir Ihnen als Leitartikel die Firma Anvo-Systems Dresden, ein Spezialist für nicht-flüchtige Speicherprodukte und das serielle nvSRAM.

Das nvSRAM kombiniert zwei Speicherelemente auf einem Chip: ein schnelles Standard SRAM und ein nicht-flüchtiges, Energie-effizientes SONOS-Flash-Speicherelement (Silizium-Oxid-Nitrid-Oxid-Silizium). Diese Technik erlaubt es, das gesamte SRAM-Memory in weniger als 15 ms parallel in den nicht-flüchtigen Speicher zu speichern. Dieses Speichern (STORE) wird auch automatisch bei einem Abfall der Betriebsspannung (POWER-DOWN) ausgelöst. Beim Wiedereinschalten (RECALL) wird das SRAM parallel in 50 μ s mit dem vorher gesicherten Daten gefüllt und steht sofort wieder zur Verfügung. Dadurch ergeben sich die für SRAMs typischen Vorteile wie kurze Zugriffszeiten und unbegrenzte Lese- und Schreibzyklen kombiniert mit den Eigenschaften eines guten nicht-flüchtigen Speichers mit 100K Schreibzyklen und einer Datenhaltung von 100 Jahren.

Einzigartige Sicherheits-Features wie die prüfungsgeschützten Speicherzugriffe Secure READ und Secure WRITE sowie ein Time-Monitoring sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit des nvSRAMs. Das nvSRAM überwacht seine Versorgungsspannung permanent. Wenn sie bei Power-Down oder

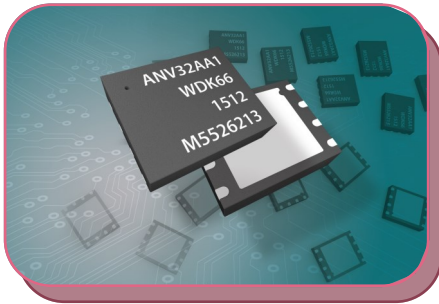
Brown-Out unter einen kritischen Wert (Vswitch) absinkt entkoppelt sich der nvSRAM von der Systemspannungsversorgung, entkoppelt alle Pins und löst automatisch den internen Datentransfer zum FLASH (POWERSTORE) aus.

Für die Stromversorgung beim PowerStore ist ein am nvSRAM angeschlossener Kondensator von üblicherweise 22 μ F bis 47 μ F ausreichend. Dieser wird während Power-Up aufgeladen und speist den



nvSRAM während des ca. 8ms beanspruchenden PowerStore. Die Energieeffizienz der Speicher wurde so weit optimiert, dass für einen AutoStore-Zyklus nur ca. 20 μ Ws benötigt werden.

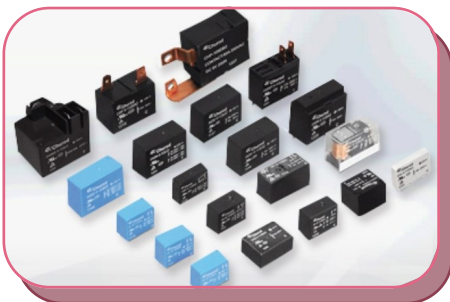
Spezifikationen des 1Mbit nvSRAM finden Sie auf der nächsten Seite.



nvSRAM ANV32AA1W (Speicherkapazität 1 Mbit) als Ersatz für teure MRAM's und FRAM's

Schnelles Standard SRAM plus Nicht-flüchtiges, Energie-effizientes FLASH-Speicherelement auf einem Chip:

- ⇒ Gesamtes SRAM wird in weniger als 6ms im Flash abgespeichert (STORE)
- ⇒ Beim Wiedereinschalten stehen Daten in 50µs zur Verfügung (RECALL)
- ⇒ Kurze Zugriffszeiten und unbegrenzte Anzahl von Lese- und Schreibzyklen (SRAM)
- ⇒ 100k Schreibzyklen und Datenhaltung von 100 Jahren (FLASH)
- ⇒ Prüfsummengeschützte Speicherzugriffe
- ⇒ Temperaturbereich von -40°C bis +85°C
- ⇒ SPI Interface mit max. Taktrate 66 MHz, I²C Interface bis 1MHz, (Quad SPI bis 108 MHz Taktrate in Vorbereitung)



Kleinsignal- und Power-Relais zu günstigen Preisen in hoher Qualität

Applikationen:

- ⇒ Standard Anwendungen (ab 1A)
- ⇒ Solar Photovoltaik (Versionen mit 16A, 35A, 48A, 90A)
- ⇒ EV (Elektrische Fahrzeuge und Ladestationen) 60A ~ 400A
- ⇒ Network Power (Telecom Netzteile und Inverter) 80A ~ 150A

Besondere Eigenschaften:

- ⇒ Vollautomatische Produktions- und Inspektionslinien für gleichbleibende Produktqualität
- ⇒ Alle Tests werden mit 130.000 Zyklen bei 155°C durchgeführt
- ⇒ Internationale Qualitätszertifikate wie ISO9001, ISO14001, TS16949



X-60 Series – Industrial 2.5" SATA Solid State Drive

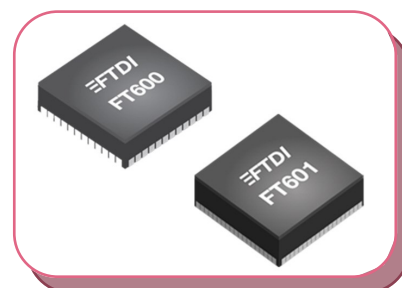
durabit™ Hoher Datendurchsatz bei bestem Langzeitverhalten

- ⇒ Kapazitäten: 30 GB, 60 GB, 120 GB, 240 GB, 480 GB
- ⇒ Formfaktor: 2.5" SATA SSD (70 mm x 100 mm x 7 mm)
- ⇒ Konformität: SATA Revision 3.1 - 6 Gbit/s (3 Gbit/s and 1.5 Gbit/s rückwärts kompatibel)
- ⇒ Schreib-/Lese Geschwindigkeit: Sequentielles Lesen bis 520 MBytes/s, sequentielles Schreiben bis 450 MBytes/s
- ⇒ Arbeitstemperaturbereich 0°C bis 70°C kommerzielle und -40°C bis +85°C industrielle Version
- ⇒ Betriebsspannung: 5 V ± 10%
- ⇒ Leistungsaufnahme bei max. Kapazität): Lesen: 1,9 W; Schreiben: 3,7 W; Leerlauf: 475 mW; Schlafmodus: 100 mW
- ⇒ Datenerhalt: 10 Jahre
- ⇒ Fixed BOM / LTB und PCN Prozess

FT60x series - SuperSpeed USB3.0 für industrielle Anwendungen

Diese Bausteinfamilie ermöglicht eine schnellere Übertragung mit gleichzeitig höhere Datenvolumen als jemals zuvor:

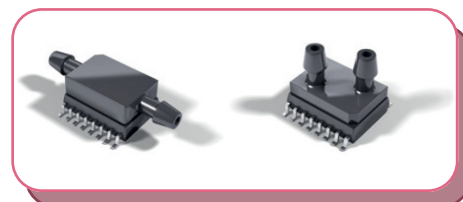
- ⇒ Support für USB 3.0 SuperSpeed (5Gbps), USB High Speed (480Mbps) und USB 2.0 Full Speed (12Mbps) Übertragungen
- ⇒ Verfügbar mit 16bit oder 32bit breiten parallelen FIFO Interface
- ⇒ Unterstützt 2 parallele slave FIFO Bus Protokolle mit Burst-Raten bis zu 400MBps
- ⇒ Unterstützt ein Mehrkanal FIFO Interface
- ⇒ Bis zu 8 konfigurierbaren Endpunkte (Pipes) möglich
- ⇒ Eingebautes 16kB FIFO Datenpuffer RAM
- ⇒ Unterstützt mehrere I/O Spannungen: 1.8V, 2.5V und 3.3V



SM5221, SM6221 Digitale Niederdruck-MEMS-Sensoren

Diese digitalen Niederdruck-MEMS-Sensoren sind für Medizin-Anwendungen (Ventilatoren, Wundtherapie, Fluidabführgeräte) und Industrieprodukte (Gasdurchfluss- und pneumatische Druckmessungen) bestens geeignet:

- ⇒ Messbereiche von 0,3 bis 2,0 PSI (21 bis 140cm H₂O)
- ⇒ Druckbereich von 0,3 bis 30 PSI
- ⇒ Voll kompensiertes Ausgangssignal
- ⇒ Integrierte Temperaturkompensation
- ⇒ Genauigkeit und -Verschiebung von weniger als 1%
- ⇒ 14-bit I²C Schnittstelle
- ⇒ Gehäuse mit vertikalen oder horizontalen Ports
- ⇒ Standard-JEDEC SOIC-16-Gehäuse



WT 8266-S1 Low-Cost industrial 802.11 b/g/n WiFi-Modul

WT8266-S1 ist ein Hochleistungs-Embedded Wi-Fi Netzwerk Modul mit hohem Datendurchsatz und niedrigem Stromverbrauch. Es erfüllt alle IoT-Applikationsanforderungen in der Gebäudeautomatisierung, bei Health-Care Systemen und im Smart-Home Bereich:

- ⇒ Integrierter TCP/IP Stack und PCB-Antenne
- ⇒ Zulassung CE, RoHS / FCC / IC / Telekom / KC (modulabhängig)
- ⇒ Industrieller Temperaturbereich von -40°C bis +85°C
- ⇒ Bis zu 10 Jahren Produktverfügbarkeit
- ⇒ Kleinste Abmessungen (z.B. 18.6 mm * 15.0 mm)
- ⇒ Kundenspezifische Entwicklungen sind möglich
- ⇒ Low-Cost Entwicklungskits für alle Module verfügbar
- ⇒ WT8266-S2 mit Keramikantenne + U.FL Stecker
- ⇒ Demnächst auch mit Bluetooth 4.2 und WiFi 802.11 b/g/n auf einem Modul





SIMOS Elektronik Vertriebs GmbH
 Fraunhoferstraße 9
 85221 Dachau
 Telefon: 08131-29276-0
 Fax: 08131-29276-99
 E-Mail: info@simos.de

Geschäftsführer:
 Gerhard Huber
 Benedikt Brenner

**Sie finden uns
 auch im Web:
www.simos.de**

Herzlich Willkommen bei SIMOS Elektronik

Als freies, konzernunabhängiges, im Privatbesitz befindliches Unternehmen, haben wir es uns zum Ziel gemacht, den zentraleuropäischen Markt mit Halbleiterbauelementen, passiven und elektromechanischen Komponenten und Optoelektronik nach dem neusten Stand der Technik zu betreuen. Qualität, Service, Logistik und Kompetenz gehören zu unseren Stärken. Unser Personal ist unser Kapital um dieses hohe Ziel zu erreichen.

Unser Serviceangebot:

- ⇒ Vertrags-Distributor
- ⇒ Repräsentant (Rep)
- ⇒ Stocking-Rep
- ⇒ Weltweite Bauelementbeschaffung auch für abgekündigte, schwer beschaffbare Bausteine
- ⇒ Just-in-time-Lieferungen
- ⇒ Ship-to-Stock-Lieferungen
- ⇒ Design-In-Unterstützung
- ⇒ Applikationsunterstützung
- ⇒ Kabelkonfektionierung
- ⇒ Programmierservice für alle Bausteine

LineCard

